

Б(2) *Токопроводящая поверхность*  
4 места.

*Габаритно-установочные размеры*

Обозначение	L	L1	Масса максимальная
Шасси комплекса сбора данных КСД "Базис" с десятью слотами КСД/Ш110	294	282	3,2
Шасси комплекса сбора данных КСД "Базис" с восемью слотами КСД/Ш108	254	242	2,8
Шасси комплекса сбора данных КСД "Базис" с шестью слотами КСД/Ш106	214	202	2,4
Шасси комплекса сбора данных КСД "Базис" с четырьмя слотами КСД/Ш104	174	162	2,0

1. Неуказанные предельные отклонения установочных размеров по ОСТ 1 00022-80.
2. \*Размер выхода модуля памяти КСД/МП11 из шасси накопителя не менее 110 мм.
3. Модули А06/КСД и заглушки КСД/301 даны в качестве примера
4. Металлизация по ОСТ1 01025-82. Переходное сопротивление не более 2000 мКОм

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Козлов		
Пров.		Лаврова		
Т.контр.		Щербаков		
М.эксп.		Кондрашов		
Н.контр.		Куценко		
Утв.		Федосов		

**РФМГ.794.121.001ГЧ**

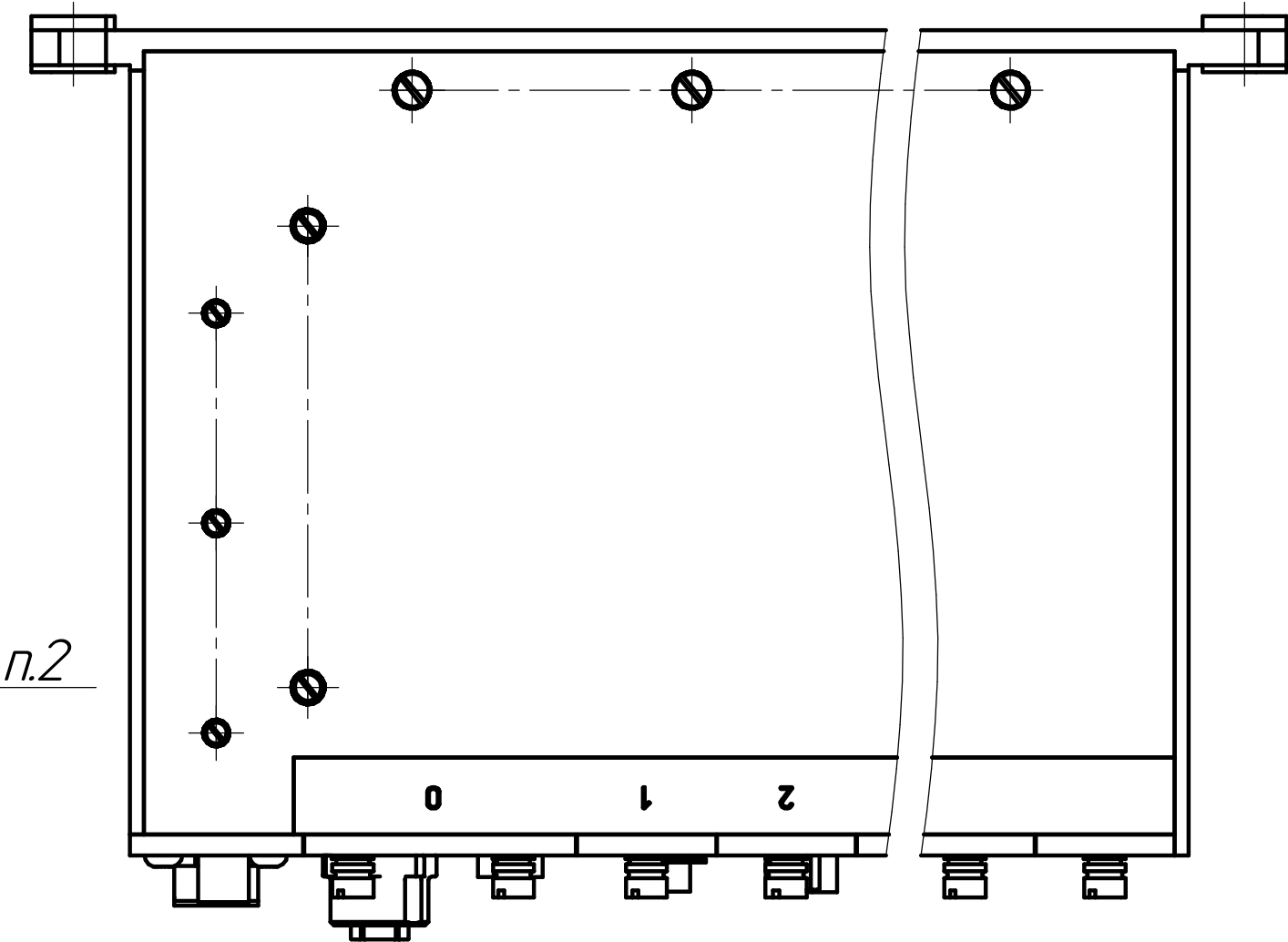
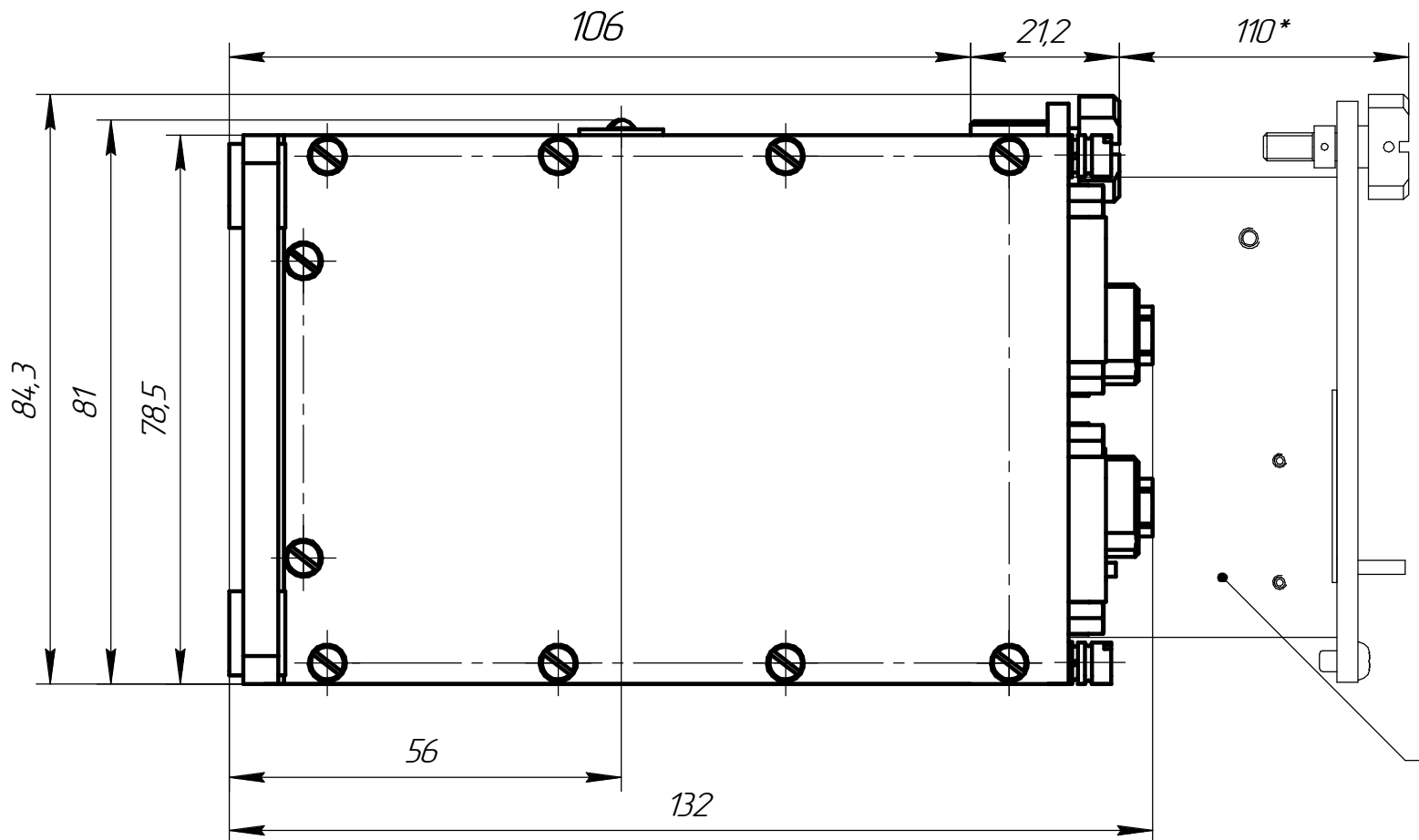
Комплекс сбора данных "Базис"  
Габаритный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
01	см. табл.	1:1
Лист 1	Листов 2	

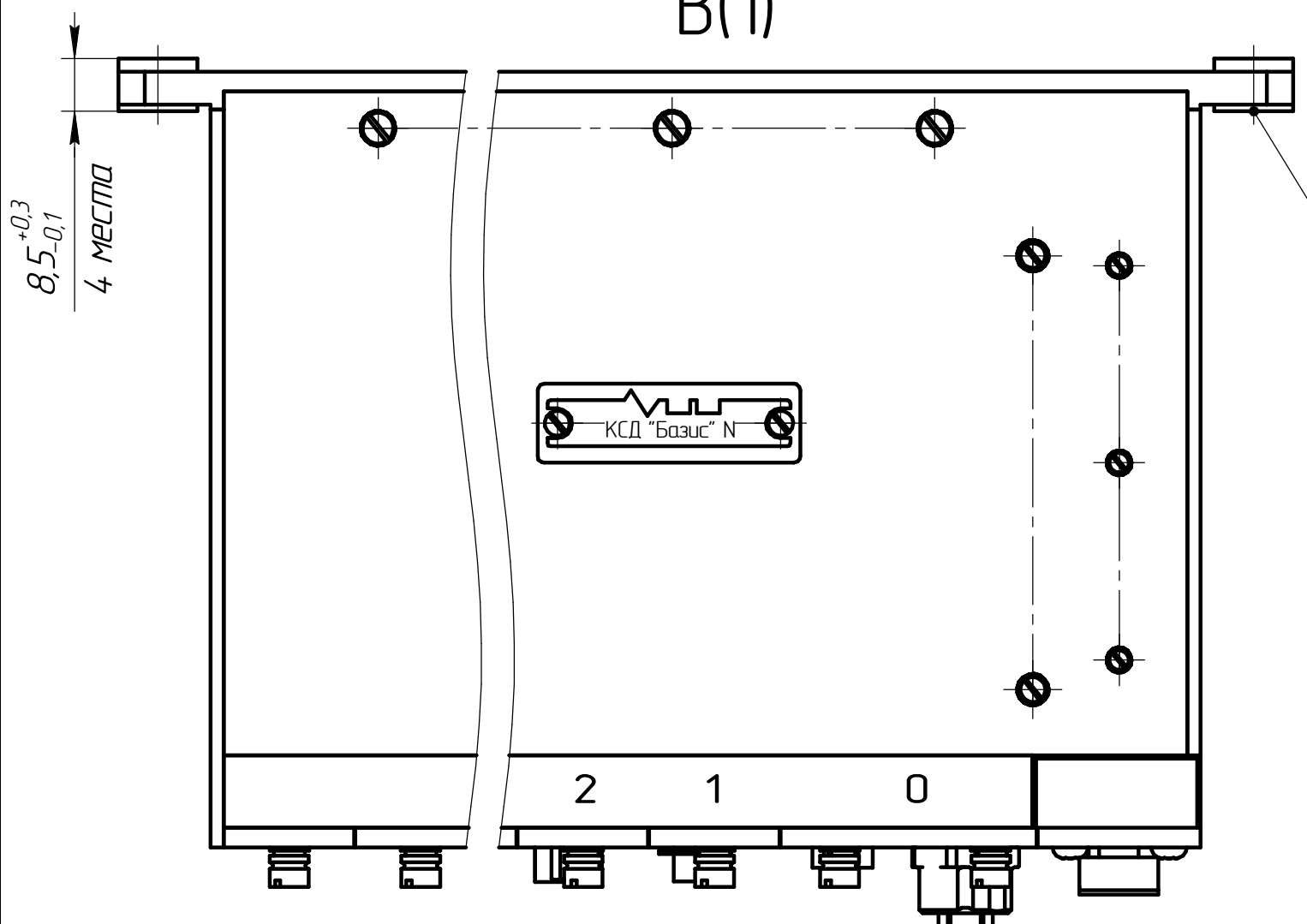
**АО "Элистрех"**

A(1)

БQ(1)



B(1)



Токопроводящая поверхность

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата

8,5<sup>+0,3</sup>  
4 места

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------